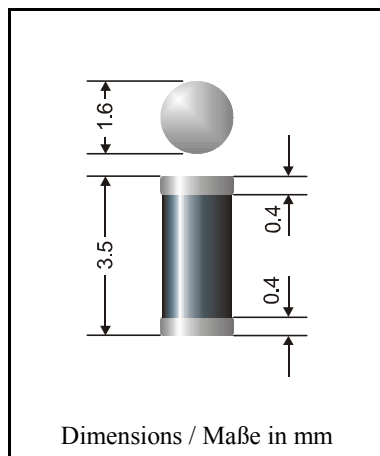


**Surface mount bidirectional
Silicon-Trigger-Diodes (DIAC)**
**Bidirektionale Silizium-Trigger-Dioden
für die Oberflächenmontage (DIAC)**


Breakover voltage Durchbruchsspannung	28 ... 45 V
Plastic case MiniMELF Kunststoffgehäuse MiniMELF	SOD-80 DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Maximum ratings
Grenzwerte

Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 50^\circ\text{C}$	P_{tot}	150 mW ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$t \leq 20 \mu\text{s}$	I_{FRM}	2 A ¹⁾
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	- 50...+100°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	- 50...+150°C

Characteristics
Kennwerte

Breakdown voltage Durchbruchsspannung	$dV/dt = 10\text{V}/\mu\text{s}$	BR 100/03 LLD BR 100/031 LLD BR 100/04 LLD	V_{BO}	28 ... 36 V 30 ... 34 V 35 ... 45 V
Breakdown current – Durchbruchstrom		$V = 98 \% V_{\text{BO}}$	I_{BO}	< 50 μA
Asymmetry of breakdown voltage Unsymmetrie der Durchbruchspannung		$ V_{(\text{BO})\text{F}} - V_{(\text{BO})\text{R}} $	ΔV_{BO}	< 3.8 V
Foldback voltage – Spannungs-Rücksprung $\Delta I = I_{\text{BO}}$ to/auf $I_{\text{F}} = 10 \text{ mA}$	$dV/dt = 10\text{V}/\mu\text{s}$		$\Delta V_{\text{F/R}}$	> 5 V
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 300 K/W ¹⁾

¹⁾ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

